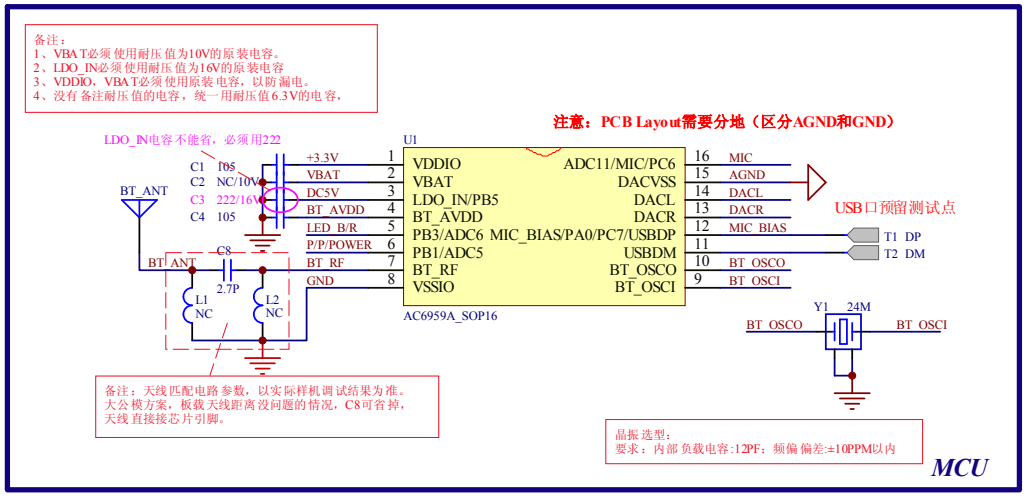
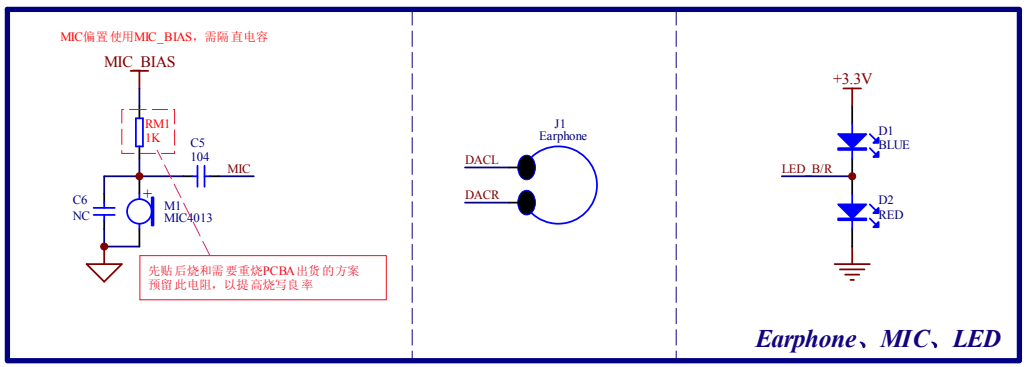
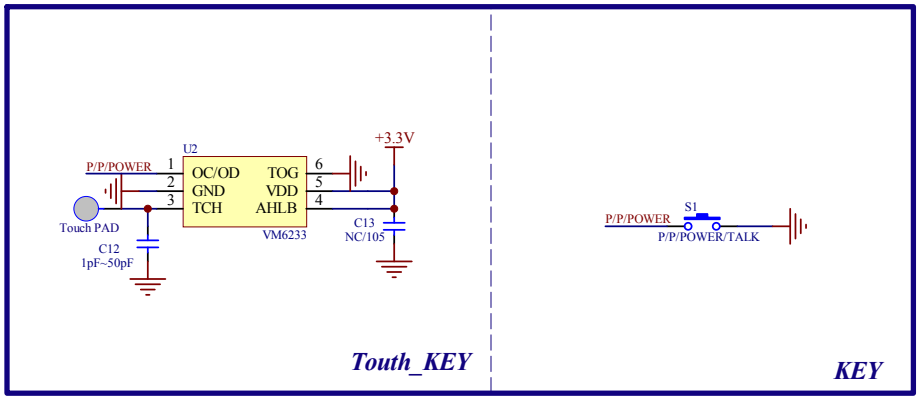
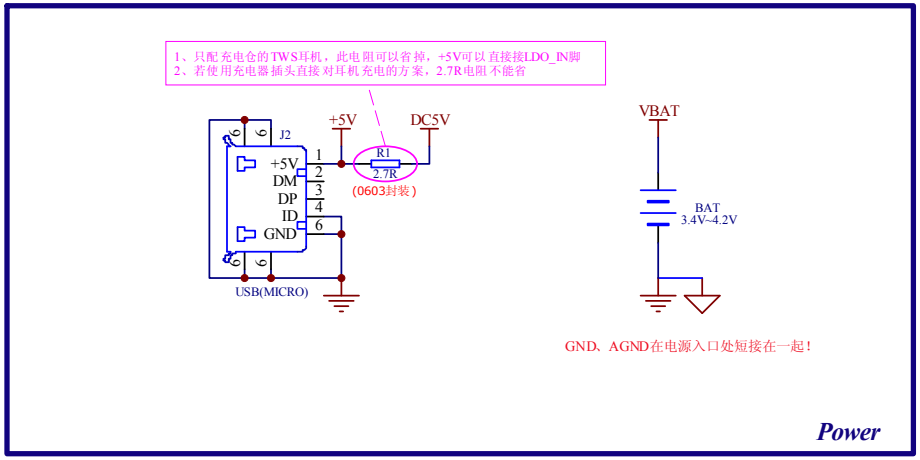

备注：
1、VBAT必须使用耐压值为10V的原装电容。
2、LDO_IN必须使用耐压值为16V的原装电容
3、VDDIO，VBAT必须使用原装电容，以防漏电。
4、没有备注耐压值的电容，统一用耐压值6.3V的电容，
注意：PCB Layout需要分地（区分AGND和GND）
LDO_IN电容不能省，必须用222
U1
C1 105
C2 NC/10V
C3 222/16V
C4 105
+3.3V
VBAT
DC5V
BT_AVDD
LED_B/R
P/P/POWER
BT_RF
GND
VDDIO
VBAT
LDO_IN/PB5
BT_AVDD
PB3/ADC6 MIC_BIAS/PA0/PC7/USBDP
PB1/ADC5
BT_RF
VSSIO
ADC11/MIC/PC6
DACVSS
DACL
DACR
MIC_BIAS
USBDM
BT_OSCO
BT_OSCI
MIC
AGND
DACL
DACR
MIC_BIAS
BT_OSCO
BT_OSCI
USB口预留测试点
T1 DP
T2 DM
AC6959A_SOP16
BT_ANT
C8
2.7P
L1
NC
L2
NC
Y1 24M
BT_OSCO
BT_OSCI
备注：天线匹配电路参数，以实际样机调试结果为准。
大公模方案，板载天线距离没问题的情况，C8可省掉，
天线直接接芯片引脚。
晶振选型：
要求：内部负载电容:12PF；频偏偏差:±10PPM以内
MCU


MIC偏置使用MIC_BIAS，需隔直电容
MIC_BIAS
RM1
1K
C5
104
MIC
C6
NC
M1
MIC4013
先贴后烧和需要重烧PCBA出货的方案
预留此电阻，以提高烧写良率
J1
Earphone
DACL
DACR
+3.3V
D1
BLUE
LED_B/R
D2
RED
Earphone、MIC、LED


U2
P/P/POWER
Touch PAD
C12
1pF~50pF
OC/OD
GND
TCH
TOG
VDD
AHLB
VM6233
+3.3V
C13
NC/105
Touch_KEY
S1
P/P/POWER
P/P/POWER/TALK
KEY


1、只配充电仓的TWS耳机，此电阻可以省掉，+5V可以直接接LDO_IN脚
2、若使用充电器插头直接对耳机充电的方案，2.7R电阻不能省
J2
+5V
DM
DP
ID
GND
USB(MICRO)
+5V
DC5V
R1
2.7R
(0603封装)
VBAT
BAT
3.4V~4.2V
GND、AGND在电源入口处短接在一起！
Power